

名称：中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所测试分析中心

地址：江苏省苏州市苏州工业园区若水路 398 号

注册号：CNAS L7180

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 01 月 29 日 截止日期：2029 年 12 月 07 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	固体材料	1	粒度	粒度分析—光子相关光谱法 GB/T 19627-2005	只测：（1-10000）nm	2024-01-29
				粒度分析 动态光散射法（DLS） GB/T 29022-2021	只测：（1-10000）nm	2024-01-29
		2	长度	纳米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 20307-2006	只测：（10-500）nm	2024-01-29
				微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008	只测：（500-10000）nm	2024-01-29
		3	微观形貌	扫描电子显微镜分析方法通则 JY/T 0584-2020	不用 EBSD	2024-01-29
		4	显微结构	透射电子显微镜分析方法通则 JY/T 0581-2020	只测：质厚衬度像、衍射衬度明	2024-01-29



No. CNAS L7180

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				微束分析 分析电子显微术 透射电镜选区电子衍射分析方法 GB/T 18907-2013	场像和暗场像、高分辨像、选区电子衍射	2024-01-29
		5	微区元素能谱分析	微束分析 能谱法定量分析 GB/T 17359-2012	只测:Be-U	2024-01-29
				扫描电子显微镜分析方法通则 JY/T 0584-2020	只测:Be-U	2024-01-29
		6	物相的定性分析	多晶体 X 射线衍射方法通则 JY/T 0587-2020 4.1	只测多晶材料	2024-01-29
		7	位错密度	氮化镓单晶位错密度的测量 阴极荧光显微镜法 GB/T 32282-2015	只测: 每平方厘米 1E3 至 5E8	2024-01-29
		8	粗糙度	氮化镓单晶衬底表面粗糙度的原子力显微镜检验法 GB/T 32189-2015	只测: 小于 10nm	2024-01-29
				原子力显微镜测量溅射薄膜表面粗糙度的方法 GB/T 31227-2014	只测: 小于 100nm	2024-01-29
		9	X 射线双晶摇摆曲线半高宽	LED 发光用氮化镓基外延片 GB/T 30854-2014 附录 E		2024-01-29
				氮化镓单晶衬底片 X 射线双晶摇摆曲线半高宽测试方法 GB/T 32188-2015		2024-01-29
		10	薄膜厚度	硅衬底上绝缘体薄膜厚度及折射率的椭圆偏振测试方法 YS/T 839-2012		2024-01-29
		11	定性分析特征吸收	红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2019	只测: (400-4000) cm ⁻¹	2024-01-29
		12	半导体单晶晶向	半导体单晶晶向测定方法 GB/T 1555-2009 方法一	只测半导体单晶材料	2024-01-29



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	纳米薄膜厚度	纳米技术 原子力显微术测定纳米薄膜厚度的方法 GB / T 36969-2018		2024-01-29
		14	直径	碳化硅单晶片直径测试方法 GB/T 30866-2014	只测碳化硅单晶片	2024-01-29
		15	载流子浓度	氮化镓衬底片载流子浓度的测试 拉曼光谱法 GB/T 36705-2018	只测氮化镓衬底片	2024-01-29
		16	Z 衬度像	透射电子显微镜分析方法通则 JY/T 0581-2020		2024-01-29
		17	X 射线能谱分析	透射电子显微镜分析方法通则 JY/T 0581-2020	只测:Be-U	2024-01-29
2	场效应晶体管	1	漏极电流	半导体器件分立器件 第 8 部分：场效应晶体管 GB/T 4586-94 第四章 3	只测：电压：0-200V 电流：0~1A	2024-01-29



在线扫码获取验证